

半 导 体 学 报

第 4 卷 第 1 期 1983 年 1 月

目 录

赝原子轨道集团方法计算 Si 和 GaAs 中的空位	夏建白 (1)
键环作用对四面体配位半导体的电子态密度的影响	徐家进 莫 党 (10)
代位式碳在硅单晶中的局域模与红外吸收	陈畅生 张哲华 叶亦英 (20)
高掺杂半导体中补偿程度和注入水平对带尾结构的影响	郭长志 李国华 (29)
氧化膜/InGaAsP 界面物理性质的研究	陈克铭 仇兰华 陈维德 (37)
非均匀半导体激光器传输特性的理论分析	单永政 杜宝勋 (47)
离子注入硅片的 CW CO ₂ 激光退火固相外延模型	沈金萱 屈逢源 (56)
Al-SiO ₂ -Si(n) 系统的电子辐照效应	包宗明 张秀森 杨恒青 张增光 (64)
用真空紫外辐照研究 Si-SiO ₂ 界面的氧化层陷阱和界面态	杜瑞瑞 孙恒慧 董国胜 (69)

研 究 简 报

用 AES 及椭圆仪研究硅上超薄氧化层	张家慰 赵正平 (78)
9 微米红外吸收法测定硅单晶中氧含量的标定曲线	
李月珍 何焕南 赵关弟 严荣华 吕庆仁 祁明维 章家鼎 华芝芬 (81)	
光荧光法测定硅中磷、硼含量	
.....孟庆惠 于 鲲 李永康 许振嘉 陈廷杰 吴灵犀 徐寿定 (86)	
一种光掩模缺陷检查技术	傅丽珍 王家楫 (90)
液相外延生长的 Al _x Ga _{1-x} As 中 Al 组分分布及少子扩散长度的研究	
.....刘宏勋 陈焜令 虞丽生 (93)	
反应离子束刻蚀及其应用	金维新 孟宪光 尤大伟 胥兴才 (97)
InGaAsP/InP 双异质结发光管光功率的温度和饱和特性	张桂成 水海龙 (101)